

000091

발송번호 : 9-5-2002-011637927

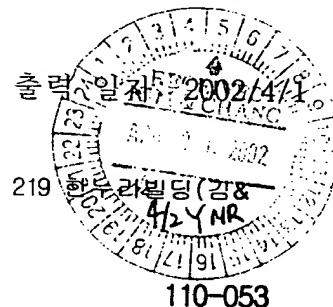
발송일자 : 2002.03.30

제출기일 : 2002.05.30

수신 : 서울 종로구 내자동 219

장 특허법률사무소)

장수길 귀하



특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 미쓰비시덴키 가부시카가이샤 (출원인코드: 519980960919)
주소 일본국 도쿄도 지요다구 마루노우치 2초메 2반 3고

대리인 성명 장수길 외 2명
주소 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&장 특허법률사무소)

출원번호 10-1998-0041271

발명의 명칭 반도체 장치 및 그 제조 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서 또는/및 보정서를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원발명은 그 출원한 날전에 한 출원으로서 이 출원후에 공개된 1998년 출원 제14850호(특허공개 제1999-6403호 참조)의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 것이므로 (이 출원의 발명자가 그 출원전에 출원한 상기 발명자와 동일하지 않으며 또한 이 출원시 출원인이 그 출원전에 출원한 상기 특허출원의 출원인과 동일하지 않음) 특허법 제29조제3항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

본 출원은 반도체 장치 및 그 제조방법에 관한 것으로 특허청구범위의 청구항 제3항은 절연막에 형성된 개구를 도전체막으로 매립한 후 절연막 상의 도전체막을 화학적 에칭에 의해 제거한 다음 절연막을 화학 기계적 연마에 의해 연마하여 평탄화함을 특징으로 하고 있는데, 본원 발명보다 먼저 출원된 특허출원 1998-14850호(1998.04.25 출원, 1997.06.11 국내우선권 주장, 1999.01.25 공개, 이하 인용출원이라함)의 최초의 출원명세서 또는 도면(특허출원 1997-24146호 참조)에는 절연층에 형성된 콘택 홀을 도전층으로 매립한 다음 도전층을 습식 내지 건식 방법에 의해 에치 백 공정으로 식각하여 콘택 플러그를 형성하고 CMP 공정으로 콘택 플러그를 포함하는 절연층을 평탄화 하는 반도체 소자의 콘택 플러그 형성 방법이 기재되어 있는 바, 본원 발명과 인용출원 발명의 구성을 대비하여 보면 본원 발명의 절연막에 형성된 개구는 인용출원의 절연층에 형성된 콘택 홀에 해당되고 본원 발명의 도전체막의 화학적 에칭은 인용출원의 도전층의 습식 또는 건식 식각에 의한 에치 백에 해당되고 본원 발명의 절연막의 화학 기계적 연마에 의한 평탄화는 인용출원의 CMP에 의한 절연층의 평탄화에 해당되므로 본원의 청구항 제3항에 기재된 발명은 인용출원의 최초 출원 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 것으로 판단되고 따라서 청구항 제3항은 특허법 제29조제3항에 의해 특허 받을 수 없습니다.

[첨 부]

첨부1 대한민국특허공개99-6403 끝.

출력 일자: 2002/4/1

2002.03.30

특허청

심사4국

반도체1 심사담당관실

심사관 권인희



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5727 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터